

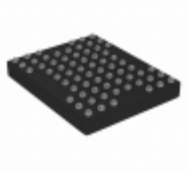
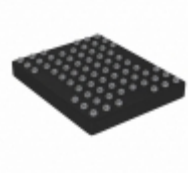


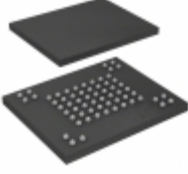


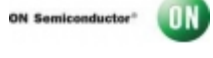
 <p>TOSHIBA Leading Innovation >>></p>	<p>TC58NVG0S3HTA00</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: TC58NVG0S3HTA00</p> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Memory America, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: IC FLASH 1G PARALLEL 48TSOP I</p> <p>Datenblätter:  TC58NVG0S3HTA00.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 642 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p><small>Image may be representation. See specs for product details.</small></p>	

Spezifikationen

Teilenummer	TC58NVG0S3HTA00
Hersteller	Toshiba Memory America, Inc.
Beschreibung	IC FLASH 1G PARALLEL 48TSOP I
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	642 pcs Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	25ns
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 3.6 V
Technologie	FLASH - NAND (SLC)
Supplier Device-Gehäuse	48-TSOP I
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width)
Andere Namen	TC58NVG0S3HTA00B4H
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	1Gb (128M x 8)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	FLASH
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 1Gb (128M x 8) Parallel
Zugriffszeit	25ns

TC58NVG0S3HTA00 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TC58NVG0S3HTA00-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TC58NVG0S3HTA00 Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TC58NVG0S3HTA00 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TC58NVG0S3HBAI6 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 1GBIT 25NS 67FBGA</p>	 <p>TC58NVG0S3HBAI6 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 1G PARALLEL 67VFBGA</p>	 <p>TC58NVG0S3HTAI0B4H TOSHIBA TC58NVG0S3HTAI0B4H TOSHIBA</p>	 <p>TC58NVG0S3FTA00 TOSHIBA TC58NVG0S3FTA00 TOSHIBA</p>
 <p>TC58NVG0S3HBAI4 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 1G PARALLEL 63TFBGA</p>	 <p>TC58NVG0S3HTAI0 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 1GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p>TC58NVG0S3HTA00 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 1GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p>TC58NVG0S3HTAI0 ON TC58NVG0S3HTAI0 ON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TC58NVG0S3HTA00 Toshiba Memory America, Inc.	TC58NVG0S3HTA00 Datenblatt	TC58NVG0S3HTA00-Datenblätter	TC58NVG0S3HTA00 PDF	Toshiba Memory America, Inc. TC58NVG0S3HTA00
TC58NVG0S3HTA00 Electronic	TC58NVG0S3HTA00-Komponenten	TC58NVG0S3HTA00-Verteiler	TC58NVG0S3HTA00-Bild	TC58NVG0S3HTA00-Teil
TC58NVG0S3HTA00 Preis	TC58NVG0S3HTA00 Hersteller	TC58NVG0S3HTA00 Bild	TC58NVG0S3HTA00 Aktie	TC58NVG0S3HTA00 Inventar
TC58NVG0S3HTA00 Neu	TC58NVG0S3HTA00 Original	TC58NVG0S3HTA00 garantiert	TC58NVG0S3HTA00 RFQ	TC58NVG0S3HTA00 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited